

2Д918

полупроводниковые диодные матрицы с общим анодом

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диодные матрицы полупроводниковые (ДМП) 2Д918Б-1, 2Д918Г-1 предназначены для применения в неремонтируемых гибридных схемах, блоках и аппаратуре, обеспечивающей герметизацию и защиту приборов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибков, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

Обозначение технических условий

- ДРЗ.362.036 ТУ

Рисунок 1. 2Д918Г-1

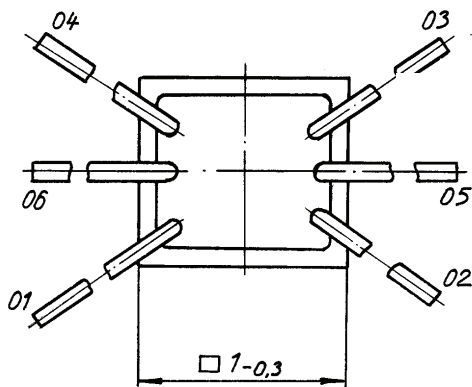
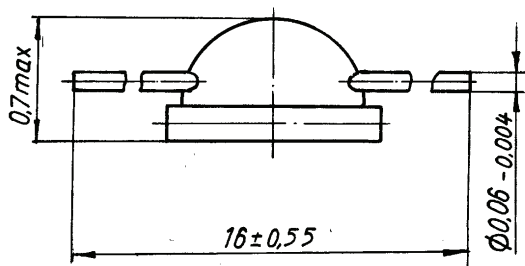


Схема соединения электродов с выводами

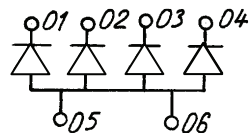


Рисунок 2. 2Д918Б-1
остальное см. рисунок 1

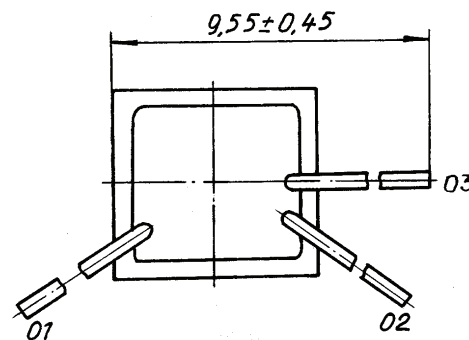
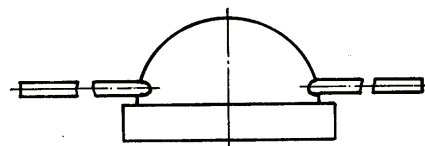


Схема соединения электродов с выводами

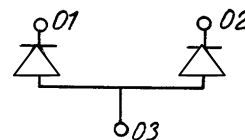


Таблица 1. Основные электрические параметры 2Д918 при $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а
		не более
Постоянный обратный ток, мкА, при $U_{\text{обр}} = 40\text{ В}$	$I_{\text{обр}}$	5,0
Постоянное прямое напряжение, В, при $I_{\text{пр}} = 50\text{ мА}$	$U_{\text{пр}}$	1,0
Общая емкость диода ДМП, пФ, при $U_{\text{обр}} = 0$	$C_{\text{д}}$	6,0
Заряд восстановления диода, пКл, при $I_{\text{пр}} = 50\text{ мА}$, $U_{\text{обр,и}} = 10\text{ В}$	$Q_{\text{вос}}$	850



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>